



## MRS-G-21

- 特色**
- 磁阻元素使用 InSb 单结晶，灵敏度高、SN 比好。
  - 被测体与传感检测面有一些距离也可检知。
  - 输出与磁性体的移动速度无关，因此对静止物也可检知。
  - 传感部是纯电阻因此不易受到诱导噪音的影响。
  - 是一种在被局限的空间内可使用的小型金属壳封装的传感器。

### 绝对最大额定值 (Ta=25°C)

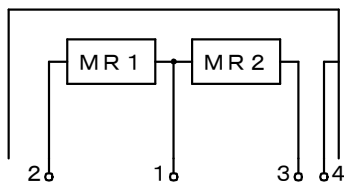
项目	符号	规定值	单位
最大应用电压	V <sub>a max</sub>	5.5	V
绝缘电压	V <sub>i</sub>	100	V
容许损耗	P <sub>D</sub>	44	mW
运行环境温度	T <sub>opg</sub>	-30 ~ +85	°C
保存环境温度	T <sub>stg</sub>	-30 ~ +85	°C

### 电气规范说明 (Ta=25°C)

项目	符号	条件	min.	Typ.	Max.	单位
输出电压	V <sub>OUT</sub>	V <sub>a</sub> =5V <sup>※1</sup>	0.4		1.1	mVrms
中点对称性	d	I=1mA <sup>※2</sup>			30	%
内部电阻	R	I=1mA	600	—	4500	Ω
内部噪音	V <sub>NI</sub>	V <sub>a</sub> =5V			50	μV <sub>p-p</sub>
压电噪音电压	V <sub>NP</sub>	V <sub>a</sub> =5V, press=10g			300	μV <sub>p-p</sub>
检测面磁通密度	B			0.085 (S ploe)		T
检测宽度	W			3		mm

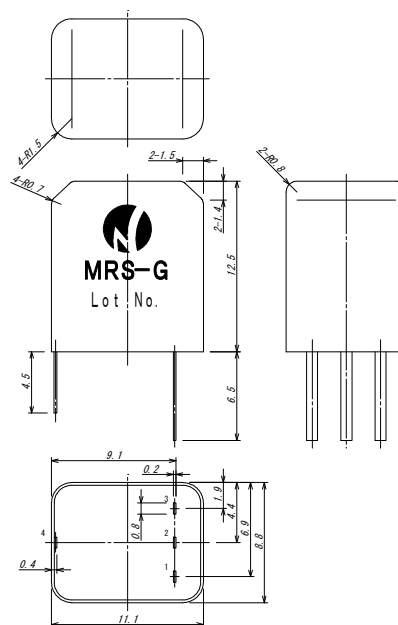
※1 Input uses the magnetic flux which occurs when it is charged with current of 50Hz, 100mA(rms) in the line of φ 0.1mm.    ※2  $d = |MR1 - MR2| / MR1 \text{ (or } MR2) * 100$

#### 内部接线图



1	Vout
2	Va
3	GND
4	FG

#### 外形尺寸图



# 产品外形等变更时不予以通告请原谅

